



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

**HB834**

对应国外型号  
KSB834

**主要用途**

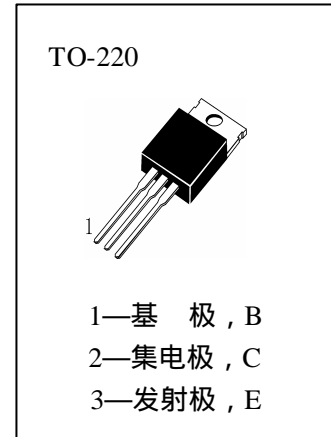
低频功率放大，伴音帧输出及电源调整(与 HD880 互补)

**极限值** ( $T_a=25$  )

$T_{stg}$	—— 贮存温度.....	-65~150
$T_j$	—— 结温.....	150
$P_C$	—— 集电极功率耗散 ( $T_c=25$ ) .....	1.5W
$P_C$	—— 集电极功率耗散 ( $T_a=25$ ) .....	30W
$V_{CBO}$	—— 集电极—基极电压.....	-60V
$V_{CEO}$	—— 集电极—发射极电压.....	-60V
$V_{EBO}$	—— 发射极—基极电压.....	-7V
$I_C$	—— 集电极电流.....	-3A
$I_B$	—— 基极电流.....	-0.5A

**电参数** ( $T_a=25$  )

**外形图及引脚排列**



参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			-100	$\mu A$	$V_{CB}=-60V, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			-100	$\mu A$	$V_{EB}=-7V, I_C=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	-60			V	$I_C=-50mA, I_B=0$
$h_{FE(1)}$	直流电流增益	60		200		$V_{CE}=-5V, I_C=-0.5A$
$h_{FE(2)}$	直流电流增益	20				$V_{CE}=-5V, I_C=-3A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降		-0.5	-1	V	$I_C=-3A, I_B=-0.3A$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压		-0.7	-1	V	$V_{CE}=-5V, I_C=-0.5A$
$f_T$	特征频率		9		MHz	$V_{CE}=-5V, I_C=-0.5A$
$C_{ob}$	共基极输出电容		150		pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1.0 MHz$
$t_{on}$	导通时间		0.4		$\mu s$	} $-I_{B1}=I_{B2}=0.2A,$ $V_{CC}=-30V$
$t_s$	载流子贮存时间		1.7		$\mu s$	
$t_f$	下降时间		0.5		$\mu s$	

**分档及其标志**

O	Y
60—120	100—200



特性曲线

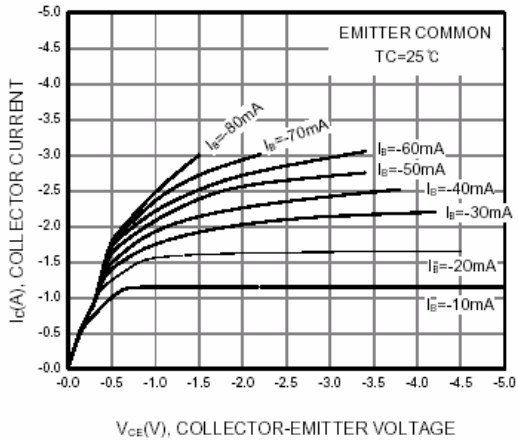


Figure 1. Static Characteristic

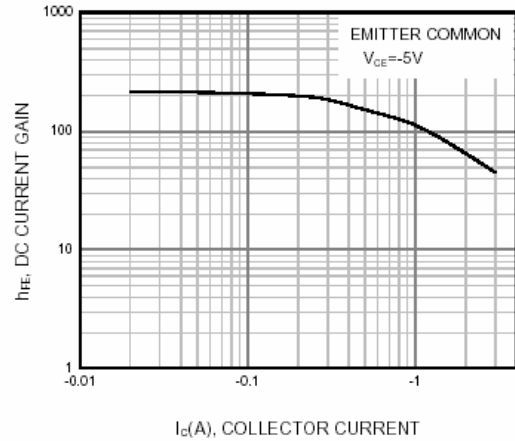


Figure 2. DC current Gain

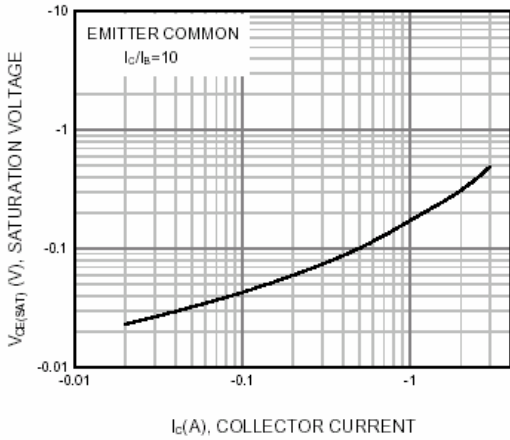


Figure 3. Collector-Emitter Saturation Voltage

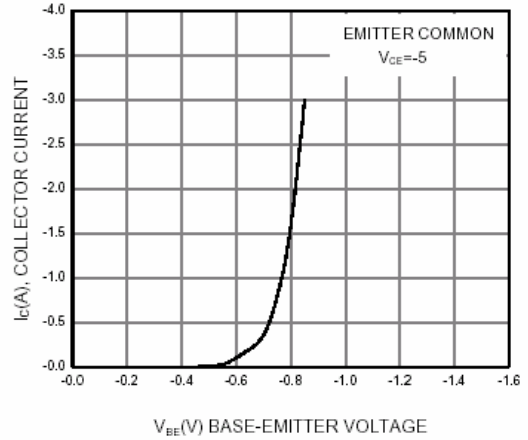


Figure 4. Base-Emitter On Voltage

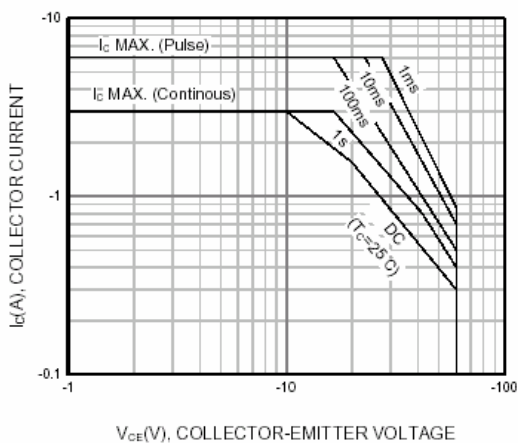


Figure 5. Safe Operating Area

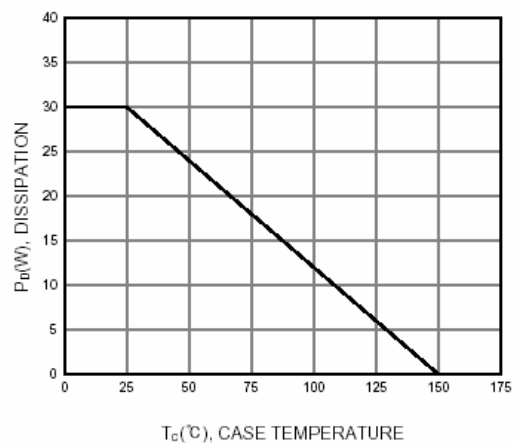


Figure 6. Power Derating